МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ИЗОЛЯЦИЮ ЗАКОРОЧЕННОЙ ЖИЛЫ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

к.т.н. С.В. Рудаков (представил д.т.н., проф. А.М. Крюков)

Предлагается методика расчета электростатического поля, которое проникает в изоляцию отдельных жил сетевых кабелей, путем закорачивания некоторых электродов с дальнейшим решением системы алгебраических уравнений.

Постановка проблемы. В сетевых кабелях контроль характеристик (частичной емкости, угла диэлектрических потерь) каждой из компонент (полиэтилен, ПВХ-пластикат) изоляции по отдельности невозможен.

Рассмотрим поле экранированной витой пары сетевого кабеля. Она содержит три электрода: две жилы и экран (рис. 1). Это дает возможность создавать в ней разные структуры электрического поля, концентрируя его, в основном, в изоляции одной жилы, или в изоляции другой, или в промежутке между ними. Электроды из участка изоляции, который необходимо исключить из контроля, закорачиваются. Часть силовых линий при этом, все-таки проникнет в закороченную часть изоляции, вызывая потери в ней (диэлектрические потери и потери на сквозную проводимость).

Анализ литературы. Существует несколько методов нахождения характеристик одного (искомого) компонента на фоне совокупных измерений: частотный, временной, пространственный [1-3]. При использовании этих методов не учитывается частичное проникновение электромагнитного поля в изоляцию отдельных элементов кабеля (полупроводящее покрытие, защитная внутренняя и внешняя оболочка). Необходимо учесть погрешность измерения, возникающую при таком влиянии полей.

Цель статьи. Разработать методику расчета электростатического поля, проникающего в изоляцию закороченной жилы сетевого кабеля.

Расчетная модель и методика расчета. Для оценки степени проникновения зондирующего поля в закороченную часть изоляции выполним расчет электростатического поля. Рассмотрим два вида испытательных схем (рис. 2): а) "две жилы — экран"; б) "жила — против второй жилы и экрана совместно". В расчетной модели учтем различие диэлектрических проницаемостей межфазного заполнения (ϵ_1) и изоляции жил (ϵ_2). Расчет выполним методом вто-

ричных зарядов, т.е. от расчетов поля в исходной задаче перейдем к расчету поля в вакууме. Расчетные модели содержат поверхности, совпадающие с

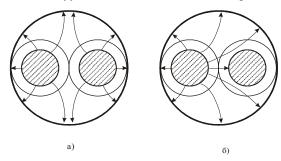


Рис. 2. Характер силовых линий поля при разных схемах испытаний.

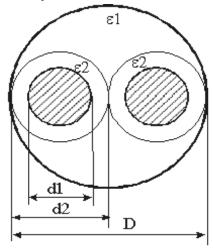


Рис. 1. Сетевой кабель

границами раздела сред исходной задачи.

Ha поверхностях расположить следует заряды (так называемые вторичные заряды) подобрать их плотности σ , Кл/м² так, чтобы достигались заданные потенциалы И выполнялись граничные условия равенства нормальных составляющих вектора электрического смещения. Тогда поле модели будет идентично полю исходной задачи. Испытуемый отрезок кабеля изогнут по форме окружности радиуса R_0 . Именно в таком виде он и помещается в испытательную камеру. Поэтому его поле - осесимметричное.

Система интегральных уравнений может быть представлена в виде:

а) для узлов, расположенных на поверхностях электродов, записываются интегральные уравнения Фредгольма первого рода:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \sigma(M) \cdot 4R_M \cdot K(k) \cdot dl_M / \sqrt{(Z_Q - Z_M)^2 + (R_Q + R_M)^2} = \phi(Q), \quad (1)$$

где K(k) – полный эллиптический интеграл первого рода;

$$k = \sqrt{4R_QR_M/((Z_Q - Z_M)^2 + (R_Q + R_M)^2)},$$

где R_Q , Z_Q — цилиндрические координаты точки Q, в которой ищется потенциал; R_M , Z_M — цилиндрические координаты точки M, в которой расположен заряд; dl_M — длина участка образующей с центром в точке M; σ (M) — плот-

ность вторичного заряда на этом участке ($K\pi/M^2$); ϵ_0 – электрическая постоянная; $\varphi(Q)$ – заданный потенциал точки Q;

б) для узлов, расположенных на границе раздела диэлектрических сред, записываются интегральные уравнения Фредгольма второго рода, отражающие условие неизменности нормальной составляющей вектора электрического смещения при переходе через эту границу:

$$\frac{\sigma(Q)}{2\varepsilon_0} - \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1} \int (n_R \cdot dE_R + n_Z \cdot dE_Z) = 0, \qquad (2)$$

где n_R , n_Z — единичные векторы нормали к границе раздела диэлектрических сред ϵ_2 и ϵ_1 ; ϵ_2 и ϵ_1 — относительные диэлектрические проницаемости сред, граничащих в точке Q со стороны отрицательного (ϵ_2) и положительного (ϵ_1) направления нормали; dE_R , dE_Z — радиальная и осевая компоненты вектора напряженности поля, создаваемого в точке Q кольцевым зарядом из точки M.

$$\begin{split} dE_R &= \frac{\sigma(M) \cdot dl_M}{4\pi\epsilon_0 R_Q} \sqrt{\frac{R_M}{R_Q}} k^2 \left\{ \frac{k}{2} K(k) \! \left(\frac{R_Q}{R_M} + 1 \right) \! - \! K'(k) \! \left[1 \! - \! \frac{k^2}{2} \! \left(\frac{R_Q}{R_M} + 1 \right) \right] \right\}; \\ dE_Z &= \frac{\sigma(M) \cdot dl_M}{4\pi\epsilon_0 R_Q} \cdot \frac{k^3 (Z_Q - Z_M)}{2\sqrt{R_Q R_M}} \big[K(k) + k \cdot K'(k) \big], \end{split}$$

где K'(k) – производная полного эллиптического интеграла по параметру k .

Интегрирование в (1) и (2) осуществляется по всем образующим кольцевых поверхностей осесимметричной модели. Выполним дискретизацию образующих и проведем нумерацию узлов сначала тех, которые относятся к электродам (узлы с номерами от 1 до N_e), а затем и остальных N_d узлов, расположенных на границах раздела диэлектрических сред. Их номера будут от N_e +1 до N_e N_e + N_d . Тогда (1) и (2) приведут к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида

$$\overline{A} \cdot \overline{\sigma} = \overline{U}$$
, (3)

где \overline{A} – квадратная матрица коэффициентов, элементы которой a_{ij} находятся по формулам [4]:

где dE'_R , dE'_Z – компоненты вектора напряженности, создаваемые единичным зарядом (плотностью 1 Кл/м^2); i, j – индексы точек, где ищутся характеристики поля (i) и расположены заряды (j); $\overline{\sigma}$ – матрицастолбец неизвестных плотностей вторичных зарядов; \overline{U} – матрицастолбец, первые N_e членов которой отражают заданные потенциалы узлов, лежащих на электродах, а остальные – равны нулю.

Численно решая СЛАУ (3), найдем плотности искомых вторичных зарядов. Тогда напряженности электростатического поля найдутся по формулам:

а) для поверхностей электродов

$$E_{i} = \frac{\sigma_{i}}{\varepsilon_{0}}, \qquad (4)$$

б) для границ раздела диэлектрических сред (нормальная составляющая напряженности)

$$E_{i} = \frac{\sigma_{i}}{2\varepsilon_{0}} \left(1 \pm \frac{1}{\alpha} \right), \tag{5}$$

где $\alpha = (\epsilon_2 - \epsilon_1)/(\epsilon_2 + \epsilon_1)$.

Формула (4) следует из теоремы Гаусса-Остроградского для элементарного цилиндра, охватывающего узел, расположенный на поверхности электрода. Образующая этого цилиндра является нормалью к поверхности электрода, а оба основания — параллельны.

Формула (5) получается аналогично для узла, расположенного на границе раздела диэлектрических сред. В этом случае собственное поле элементарного заряда $\Delta \sigma$, попавшего в цилиндр, существует по обе стороны заряда, в результате чего напряженность поля уменьшается в 2 раза (см. первое слагаемое в (2) и соответственно число 2 в знаменателе (5)). Действие же всех остальных зарядов, не попавших в цилиндр, отражается вторым слагаемым в (2) и численно равно собственному полю заряда $\Delta \sigma$, разделенному на безразмерный коэффициент α .

В (5) знак "+" выбирается при нахождении поля со стороны положительного направления нормали к границе раздела сред, а "-" – со стороны отрицательного направления. В дальнейшем находилась напряженность поля в воздушных прослойках, а поскольку векторы нормалей всех круговых границ раздела сред были ориентированы нами единообразно – наружу, то и потребовалось введение двух знаков в (5): первый знак выбирался, когда воздушная прослойка оказывалась снаружи круговой границы, второй – когда внутри.

Результаты расчетов поля. Рассчитывалась напряженность поля в заданных точках внутри изоляции каждой из жил (1 и 2). Затем рассчи-

тывались энергии электростатического поля в изоляции незакороченной жилы — W_1 и закороченной жилы — W_2 . Отношение W_2 / W_1 — коэффициент степени проникновения поля в изоляцию электродов и, по сути, является методической погрешностью измерений, возникающей при влиянии полей. Оно приведено в таблице для ряда значений толщины изоляции и соотношений диэлектрических проницаемостей сред.

Таблица 1 Коэффициент степени проникновения поля в изоляцию электродов

δ/R	$\varepsilon_2 / \varepsilon_1$	
	1	2,1
0,5	0,134	0,157
1,0	0,0906	0,117
2	0,0616	0,086

Как видно из таблицы, энергия электростатического поля в изоляции закороченной жилы может составлять $0.0616 \div 0.157$ от энергии поля в изоляции незакороченной жилы. Для кабеля с полиэтиленовой изоляцией и типовым соотношением $\delta/R=1$ величина $W_2/W_1=0.117\approx 12\%$.

Выводы. 1. Предложена расчетная модель влияния зондирующего электростатического поля на погрешность результата измерения изоляции отдельных компонент сетевых кабелей.

2. Проведена оценка числового значения относительной погрешности измерения напряженности поля в изоляции кабелей, которое позволило учесть влияние зондирующего электромагнитного поля при контроле параметров изоляции сетевых кабелей.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Шалыг Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. М.: Энергоатомиздат, 1992. 312 с.
- 2. Койков С.Н. Перспективы развития неразрушающих методов диагностики электрической изоляции // Труды НТК «Изоляции-99». СПб. 1999. С. 12 13.
- 3. Боев М.А. Техническая диагностика низковольтной полимерной изоляции // Труды НТК «Изоляции-99». СПб. 1999. С. 19 20.
- 4. Набока Б.Г. Расчеты электростатических полей в электроизоляционной технике. К.: ИСИО, 1995. 120 с.

Поступила 16.01.2004

РУДАКОВ Сергей Валерьевич, канд. техн. наук, преподаватель кафедры XBV. В 1996 году окончил XBV. Область научных интересов — методы исследования параметров изоляции электрических кабелей.